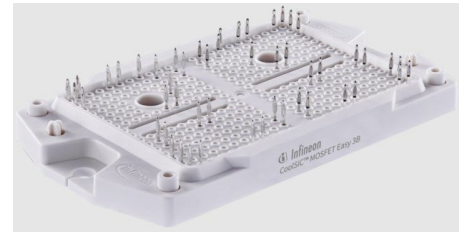


EasyPACK™ 3B CoolSiC™ MOSFET 2000 V リードタイプモジュール DF4-19MR20W3M1HF_B11

DF4-19MR20W3M1HF_B11 は、EasyPACK™ 3B パッケージに搭載された初の 2000 V CoolSiC™ MOSFET パワーモジュールです。DC1500 V アプリケーションの電力密度を高め、総システムコストを削減しながら、よりシンプルなソリューション、より少ない部品点数を実現します。

DF4-19MR20W3M1HF_B11 は、Easy 3B パッケージに 4 チョッパー構成で、最新の CoolSiC™ M1H 世代を搭載しています。2000 V SiC MOSFET は 1200 V M1H シリーズと同じ性能と利点を備えていますが、125°C で 12% 低い $R_{DS(on)}$ 、また、広いゲートソース電圧領域による高い柔軟性、最大接合温度 T_{vjop} 175°C、小型チップサイズを実現しています。



主な特長

- > 2000V CoolSiC™ MOSFET M1H
- > Easy 3B パッケージ
- > 4 チョッパー構成
- > 推奨ゲート駆動電圧ウィンドウを +15~+18 V および 0~-5 V に拡大
- > ゲート-ソース間電圧の最大値を +23 V と -10 V に拡大
- > 過負荷時の T_{vjop} は最大 175°C
- > PressFIT ピン

主な利点

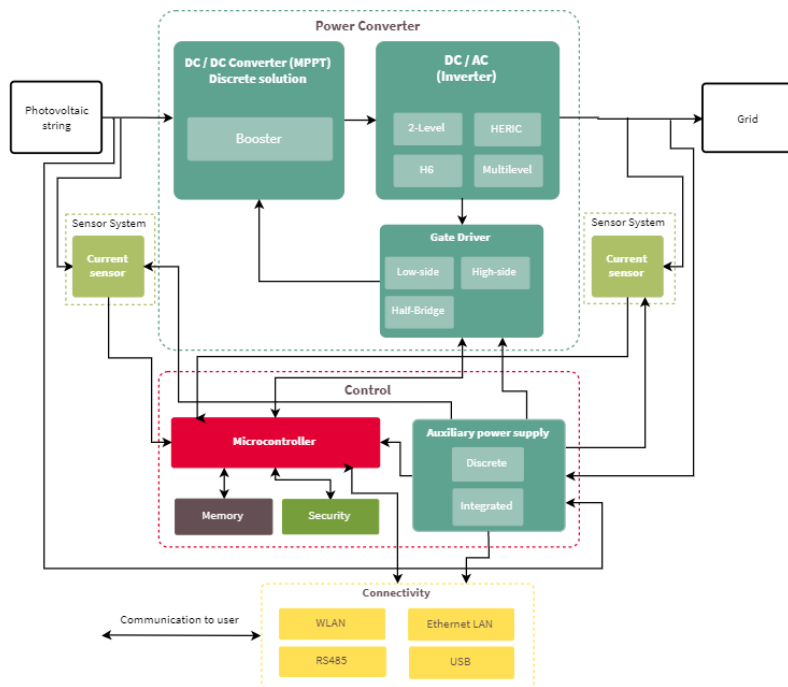
- > 半分の部品数で出力電力を増加
- > 最新の CoolSiC™ テクノロジーによりゲートオフ電圧を自由に選択可能
- > 宇宙線による故障率の低減により、1700 V 品に比べて 10 倍の FT 率を実現
- > 能動部品によるドリフトの低減

競合製品に対する優位性

- > 業界初の 2000 V SiC MOSFET

対象アプリケーション

- > 太陽光発電用パワコンのチョッパー回路



製品関連情報/オンライン サポート

[製品ページ](#)

製品概要およびユーザーマニュアルへのリンク

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
DF419MR20W3M1HFB11BPSA1	SP005677961	AG-EASY3B-3111

FAQ 【EasyPACK™ 3B CoolSiC™ MOSFET 2000 V リードタイプモジュール DF4-19MR20W3M1HF_B11】

FAQ	
1. What's the benefit of using IFX 2 kV CoolSiC™ M1H	
	As part of the latest series of Infineon CoolSiC™ M1H technology, 2 kV shares the same performance and benefits as the 1200 V voltage class series, incl. lower $R_{DS(on)}$, wider gate source voltage area for higher flexibility, a max. junction temperature of $T_{vj,op}$ of 175°C, and smaller chip sizes
2. What are the typical working conditions for this module?	
	It is intended for 1500 VDC link voltages and SiC allows high switching frequency, enable higher power density
3. Is there a further roll-out of a bigger portfolio planned?	
	Yes, we plan to release more products with our Easy module in combination with the latest series of 2 kV CoolSiC™ MOSFET technology